МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование организации управления основной памятью

Студент гр. 0382	Ильин Д.А.
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург

2022

Цель работы.

Для исследования организации управления памятью необходимо ориентироваться на тип основной памяти, реализованный в компьютере и способ организации, принятый в ОС. В лабораторной работе рассматривается не страничная память и способ управления динамическими разделами. Для реализации управления памятью в этом случае строится список занятых и свободных участков памяти. Функции ядра, обеспечивающие управление основной памятью, предусматривают и преобразуют этот список.

В лабораторной работе исследуются структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.

Постановка задачи.

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .COM, который выбирает и распечатывает следующую информацию:

- 1) Количество доступной памяти.
- 2) Размер расширенной памяти.
- 3) Выводит цепочку блоков управления памятью.

Адреса при выводе представляются щестнадцатеричными числами. Объем памяти функциями управления памятью выводится в параграфах. Необходимо преобразовать его в байты и выводить в виде десятичных чисел. Последние восемь байт МСВ выводятся как символы, не следует преобразовывать их в шестнадцатеричные числа.

Запустите программу и внимательно оцените результаты. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

Шаг 2. Измените программу таким образом, чтобы она освобождала память, которую она не занимает. Для этого используйте функцию 4Ah прерывания 21h (пример в разделе «Использование функции 4AH»). Повторите эксперимент, запустив модифицированную программу.

Сравните выходные данные с результатами, полученными на предыдущем шаге. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

Шаг 3. Измените программу еще раз таким образом, чтобы после освобождения памяти, программа запрашивала 64Кб памяти функцией 48Н прерывания 21Н. Повторите эксперимент, запустив модифицированную программу. Сравните выходные данные с результатами, полученными на предыдущих шагах. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

Шаг 4. Измените первоначальный вариант программы, запросив 64Кб памяти функцией 48Н прерывания 21Н до освобождения памяти. Обязательно обрабатывайте завершение функций ядра, проверяя флаг СF. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

Шаг 5. Оцените результаты, полученные на предыдущих шагах. Ответьте на контрольные вопросы и оформите отчет

Выполнение работы.

Исходные коды модулей представлены в приложении А.

Шаг 1. Были написаны все основные функции из задания, а именно PRINT_MEM_SIZE(выводит размер занимаемой памяти), PRINT_EXTEND_MEM_SIZE(выводит размер расширенной памяти), PRINT_MCU(выводит блик управления памятью), PRINT_CHAIN MCU(выводит цепочку блоков управления памятью).

Результат работы программы, написанной на первом шаге представлен на рисунке 1.

```
3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX -
     DOSBox 0.74-3, Cpu speed:
Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.64
Copyright (C) Microsoft Corp 1983–1988. All rights reserved.
Run File [LB1 COM.EXE]:
List File [NUL.MAP]:
Libraries [.LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment
C:\>EXEZBIN.EXE LB1_COM.EXE LB1_COM.COM
C:\>LB1_COM.COM
MEM_SIZE:
             648912
EXTEND_MEM_SIZE:
                    245760
                              016F; type of part- 0008; size of part-
                                                                             16;
lemory control unit: adress-
SC or SD-
memory control unit: adress-
                              0171; type of part- 0000; size of part-
                                                                             64;
C or SD-
mory control unit: adress-
                              0176; type of part- 0040; size of part-
                                                                            256:
SC or SD-
lemory control unit: adress-
                              0187; type of part- 0192; size of part-
                                                                            144:
SC or SD-
Memory control unit: adress-
                              0191; type of part- 0192; size of part-
                                                                         648912;
SC or SD- LB1 COM
```

Рисунок 1 – Результат запуска модуля lb3 v1.com

Шаг 2. На втором шаге была написана функция CLEAN_MEM, которая освобождает память, не занимаемую программой.

Результат работы программы, написанной на втором шаге представлен на рисунке 2.

```
::\>LB3 U2.COM
EM SIZE:
            648912
EXTEND MEM SIZE:
                   245760
                                                                             16;
Temory control unit: adress-
                             016F; type of part- 0008; size of part-
SC or SD-
1emory control unit: adress-
                             0171; type of part- 0000; size of part-
                                                                            64;
SC or SD-
Memory control unit: adress-
                             0176; type of part- 0040; size of part-
                                                                            256;
SC or SD-
1emory control unit: adress-
                             0187; type of part- 0192; size of part-
                                                                            144;
SC or SD-
Memory control unit: adress-
                             0191; type of part- 0192; size of part-
                                                                            816;
SC or SD- LB3_V2
1emory control unit: adress-
                             01C5; type of part- 0000; size of part- 648080;
SC or SD− ;⊽°ueï⊥
C:\>
```

Рисунок 2 – Результат выполнения модуля lb3 v2.com

Заметим, что на первом шаге программа занимала практически всю свободную память, однако на втором шаге свободная память выделилась в отдельный блок, который является последним на рисунке 2. Блок, в который загружена программа стал размеров, необходимых для хранения программы.

Шаг 3. Далее была написана функция EXTRA_MEM, которая дополнительно запрашивает 64 Кб памяти, при помощи функции 48h прерывания int 21.

Результат выполнения программы, написанной на третьем шаге представлен на рисунке 3.

```
C:\>LB3_V3.COM
MEM_SIZE:
             648912
EXTEND_MEM_SIZE:
                    245760
Memory control unit: adress-
                              016F; type of part- 0008; size of part-
                                                                              16;
SC or SD-
Memory control unit: adress-
                              0171; type of part- 0000; size of part-
                                                                             64;
SC or SD-
Memory control unit: adress-
                              0176; type of part- 0040; size of part-
                                                                             256;
SC or SD-
Memory control unit: adress-
SC or SD-
                                                                             144;
                              0187; type of part- 0192; size of part-
Memory control unit: adress-
                              0191; type of part- 0192; size of part-
                                                                            832;
SC or SD- LB3_V3
Memory control unit: adress-
                              01C6; type of part- 0192; size of part-
                                                                          65536;
SC or SD- LB3 V3
Memory control unit: adress-
                              1107; type of part- 0000; size of part-
                                                                         582512;
SC or SD-
  ±COM
```

Рисунок 3 – Результат выполнения модуля lb3_v3.com

Из изображения видно, что относительно предыдущего случая появился ещё один блок памяти, рассчитанный как на 64Кб, он выделился из свободной памяти.

Шаг 4. Отличие от предыдущего выполнения заключается в обратной очерёдности вызовов функций EXTRA_MEM и CLEAN_MEM(в данном случае сначала запрашивается 64Кб, а только потом высвобождается память)

Результат выполнения программы, написанной на четвёртом шаге представлен на рисунке 4.

```
C:\>LB3_V3.COM
MEM_SIZE:
            648912
EXTEND_MEM_SIZE:
                   245760
                 !!! WORNING !!! !!! WORNING !!! !!! WORNING !!!
Memory control unit: adress- 016F; type of part- 0008; size of part-
                                                                           16;
SC or SD-
Memory control unit: adress- 0171; type of part- 0000; size of part-
                                                                           64;
SC or SD-
Memory control unit: adress- 0176; type of part- 0040; size of part-
                                                                          256;
SC or SD-
Memory control unit: adress- 0187; type of part- 0192; size of part-
                                                                           144;
SC or SD-
Memory control unit: adress- 0191; type of part- 0192; size of part-
                                                                          912;
SC or SD- LB3_V3
                             01CB; type of part- 0000; size of part-
Memory control unit: adress-
                                                                       647984;
SC or SD- â·
```

Рисунок 4 – Результат выполнения модуля lb3 v3.com (изменённый)

В данной вариации выводится сообщение об ошибке, т. к. вся память уже принадлежит программе, поэтому дополнительные 64Кб выделены быть не могут.

Контрольные вопросы.

Сегментный адрес недоступной памяти:

1. Что означает «доступный объём памяти»?

Это размер оперативной памяти в системе, который используется для запуска и выполнения программы.

2. Где МСВ блок Вашей программы в списке?

На каждом шаге программе принадлежат MCB блоки, в графе SD/SC которых написано название файла.

3. Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

Размер памяти, занимаемой программой, это сумма размеров всех блоков, принадлежащих программе.

- 1) Шаг 1 648912 байт
- 2) Шаг 2 816 байт
- 3) Шаг 3 66368 байт
- 4) Шаг 4 912 байта

Выводы.

В ходе работы были исследованы структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы

приложение А.

Исходный код модулей

lb3 v1.asm:

```
; Шаблон текста программы на ассемблере для модуля типа .СОМ
        ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
        ORG 100H
    START: JMP BEGIN
    ; ДАННЫЕ
    MEM SIZE db 'MEM SIZE:
                                         ',0DH,0AH,'$'
    EXTEND_MEM_SIZE db 'EXTEND_MEM_SIZE:

MCU db 'Memory control unit: adress-

',0DH,0AH,'$'
size of part- ; SC or SD-
    ;ПРОЦЕДУРЫ
    ;-----
    TETR TO HEX PROC near
        and AL, OFh
        cmp AL,09
        jbe NEXT
        add AL,07
    NEXT: add AL, 30h
       ret
    TETR TO HEX ENDP
     ;-----
    BYTE TO HEX PROC near
     ; байт в АL переводится в два символа шестн. числа в АХ
        push CX
        mov AH, AL
        call TETR TO HEX
        xchg AL, AH
        mov CL, 4
        shr AL, CL
        call TETR_TO_HEX ;в AL старшая цифра
        рор СХ ;в АН младшая
        ret
    BYTE TO HEX ENDP
    ;-----
    WRD TO HEX PROC near
     ;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
     ; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
        push BX
        mov BH, AH
        call BYTE TO HEX
        mov [DI], AH
        dec DI
        mov [DI], AL
        dec DI
        mov AL, BH
```

```
call BYTE TO HEX
   mov [DI], AH
   dec DI
   mov [DI], AL
    pop BX
    ret
WRD TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
   push CX
   push DX
   xor AH, AH
   xor DX, DX
   mov CX, 10
loop_bd: div CX
   or DL, 30h
   mov [SI], DL
   dec SI
   xor DX, DX
   cmp AX, 10
   jae loop bd
   cmp AL,00h
   je end l
   or AL, 30h
   mov [SI], AL
end 1: pop DX
   pop CX
   ret
BYTE TO DEC ENDP
;-----
WRD_TO_DEC PROC near
; ax - paragraph, si - low digit of result
   push bx
   push dx
   mov bx, 16
   mul bx
   mov bx, 10
   convert:
       div bx
       add dl, '0'
       mov [si], dl
       dec si
       xor dx, dx
       cmp ax, 0000h
       jne convert
   pop dx
   pop bx
   ret
WRD TO DEC ENDP
print st PROC near
   mov AH, 09h
   int 21h
   ret
```

```
print_st ENDP
print_symb PROC near
   push ax
   mov ah, 02h
   int 21h
    pop ax
    ret
print symb ENDP
PRINT MEM SIZE PROC near
    push ax
   push dx
   push cx
   push bx
   push si
   MOV AH, 4AH
    MOV BX, OFFFFH ; заведомо большая память
    INT 21H
   mov si, offset MEM SIZE
    add si, 18
    mov ax, bx
    call WRD TO DEC
   mov dx, offset MEM SIZE
   call print st
    pop si
    pop bx
    pop cx
   pop dx
   pop ax
    ret
PRINT MEM SIZE ENDP
PRINT EXTEND MEM SIZE PROC near
    push ax
    push dx
   push cx
   push bx
   push si
    mov AL, 30h ; запись адреса ячейки CMOS
    out 70h,AL
    in AL,71h; чтение младшего байта
    mov BL,AL
    mov AL, 31h ; запись адреса ячейки CMOS
    out 70h, AL
    in AL,71h
    mov BH, AL
    mov si, offset EXTEND MEM SIZE
    add si, 25
    mov ax, bx
    call WRD TO DEC
    mov dx, offset EXTEND MEM SIZE
```

```
call print_st
    pop si
    pop bx
   pop cx
   pop dx
   pop ax
   ret
PRINT EXTEND_MEM_SIZE ENDP
PRINT MCU PROC near
    push ax
   push dx
   push cx
   push bx
   push si
   mov di, offset MCU
    add di, 33
   mov ax, es
    call WRD TO HEX
   mov di, offset MCU
    add di, 54
   mov ax, es:[01h]
    call WRD_TO_HEX
   mov si, offset MCU
    add si, 77
    mov ax, es:[03h]
    call WRD TO DEC
    mov di, offset MCU
    add di, 91
   mov si, 8
sc sd:
   mov bx, es:[si]
    mov [di], bx
   add si, 2
     add di, 2
    cmp si, 16
     jb sc_sd
   mov dx, offset MCU
    call print_st
   pop si
   pop bx
   pop cx
   pop dx
   pop ax
    ret
PRINT_MCU ENDP
PRINT CHAIN MCU PROC near
    push ax
    push dx
   push cx
   push bx
```

```
push si
         push es
         mov ah, 52h
         int 21h
         mov es, es: [bx-2]
     chain:
         call PRINT MCU
         mov ah, es:[0]
         cmp ah, 5Ah
         je end_
         mov ax, es
         add ax, es:[3]
         inc ax
         mov es, ax
         jmp chain
     end :
        pop es
         pop si
         pop bx
        pop cx
        pop dx
         pop ax
        ret
     PRINT CHAIN MCU ENDP
     ; КОД
     BEGIN:
         call PRINT MEM SIZE
         call PRINT EXTEND MEM SIZE
         call PRINT CHAIN MCU
     ; Выход в DOS
         xor AL, AL
         mov AH, 4Ch
         int 21H
     TESTPC ENDS
         END START ; конец модуля, START - точка входа
     lb3 v2.asm:
      ; Шаблон текста программы на ассемблере для модуля типа .СОМ
     TESTPC SEGMENT
         ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
         ORG 100H
     START: JMP BEGIN
     ; ДАННЫЕ
     MEM SIZE db 'MEM SIZE:
                                              ', ODH, OAH, '$'
     EXTEND MEM SIZE db 'EXTEND MEM SIZE:
                                                           ',ODH,OAH,'$'
     MCU db 'Memory control unit: adress-
                                                ; type of part- ;
                                              ',0DH,0AH,'$'
size of part- ; SC or SD-
```

;ПРОЦЕДУРЫ

```
;-----
TETR TO HEX PROC near
   and AL, OFh
   cmp AL,09
   jbe NEXT
   add AL,07
NEXT: add AL, 30h
   ret
TETR TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO HEX PROC near
; байт в АL переводится в два символа шестн. числа в АХ
   push CX
   mov AH, AL
   call TETR TO HEX
   xchg AL, AH
   mov CL, 4
   shr AL, CL
   call TETR TO HEX ;в AL старшая цифра
   рор СХ ;в АН младшая
   ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD TO HEX PROC near
;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
   push BX
   mov BH, AH
   call BYTE TO HEX
   mov [DI], AH
   dec DI
   mov [DI], AL
   dec DI
   mov AL, BH
   call BYTE TO HEX
   mov [DI], AH
   dec DI
   mov [DI], AL
   pop BX
    ret
WRD TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
   push CX
   push DX
   xor AH, AH
   xor DX, DX
   mov CX, 10
loop bd: div CX
   or DL,30h
   mov [SI], DL
   dec SI
   xor DX, DX
   cmp AX, 10
   jae loop bd
```

```
cmp AL,00h
    je end l
   or AL,30h
   mov [SI], AL
end 1: pop DX
   pop CX
   ret
BYTE TO DEC ENDP
;-----
WRD_TO_DEC PROC near
; ax - paragraph, si - low digit of result
   push bx
   push dx
   mov bx, 16
   mul bx
   mov bx, 10
   convert:
       div bx
        add dl, '0'
       mov [si], dl
       dec si
       xor dx, dx
        cmp ax, 0000h
        jne convert
   pop dx
   pop bx
   ret
WRD TO DEC ENDP
print_st PROC near
   mov AH, 09h
    int 21h
   ret
print_st ENDP
print_symb PROC near
   push ax
   mov ah, 02h
   int 21h
   pop ax
   ret
print symb ENDP
PRINT MEM SIZE PROC near
   push ax
   push dx
   push cx
   push bx
   push si
   MOV AH, 4AH
   MOV BX,0FFFFH ; заведомо большая память
   INT 21H
   mov si, offset MEM_SIZE
   add si, 18
```

```
mov ax, bx
    call WRD TO DEC
   mov dx, offset MEM SIZE
    call print st
   pop si
   pop bx
   pop cx
   pop dx
   pop ax
   ret
PRINT MEM SIZE ENDP
PRINT EXTEND MEM SIZE PROC near
    push ax
   push dx
   push cx
   push bx
   push si
   mov AL, 30h ; запись адреса ячейки CMOS
    out 70h, AL
    in AL,71h; чтение младшего байта
   mov BL, AL
   mov AL, 31h ; запись адреса ячейки CMOS
    out 70h, AL
    in AL,71h
    mov BH, AL
   mov si, offset EXTEND MEM SIZE
    add si, 25
   mov ax, bx
    call WRD TO DEC
   mov dx, offset EXTEND MEM SIZE
    call print_st
   pop si
   pop bx
   pop cx
   pop dx
   pop ax
   ret
PRINT EXTEND MEM SIZE ENDP
PRINT MCU PROC near
    push ax
   push dx
   push cx
   push bx
    push si
   mov di, offset MCU
   add di, 33
   mov ax, es
    call WRD TO HEX
   mov di, offset MCU
```

```
add di, 54
    mov ax, es:[01h]
    call WRD_TO_HEX
    mov si, offset MCU
    add si, 77
    mov ax, es:[03h]
    call WRD TO DEC
    mov di, offset MCU
    add di, 91
    mov si, 8
sc sd:
   mov bx, es:[si]
    mov [di], bx
    add si, 2
     add di, 2
    cmp si, 16
     jb sc_sd
   mov dx, offset MCU
    call print st
   pop si
   pop bx
   рор сх
   pop dx
   pop ax
   ret
PRINT_MCU ENDP
PRINT CHAIN MCU PROC near
    push ax
    push dx
   push cx
   push bx
   push si
   push es
   mov ah, 52h
   int 21h
   mov es, es: [bx-2]
chain:
    call PRINT MCU
    mov ah, es:[0]
    cmp ah, 5Ah
    je end_
   mov ax, es
    add ax, es:[3]
   inc ax
    mov es, ax
    jmp chain
end :
    pop es
   pop si
   pop bx
   pop cx
```

```
pop dx
         pop ax
        ret
     PRINT CHAIN MCU ENDP
     CLEAN MEM PROC near
        push ax
        push bx
        push dx
        mov ax, offset FINAL_LB3
        mov bx, 10h
        xor dx, dx
        div bx
        inc ax
        mov bx, ax
        mov al, 0
        mov ah, 4ah
        int 21h
        pop dx
        pop bx
        pop ax
        ret
     CLEAN MEM ENDP
     ; КОД
     BEGIN:
        call PRINT MEM SIZE
         call PRINT EXTEND MEM SIZE
        call CLEAN MEM
        call PRINT CHAIN MCU
     ; Выход в DOS
        xor AL, AL
        mov AH, 4Ch
        int 21H
     FINAL LB3:
     TESTPC ENDS
        END START ; конец модуля, START - точка входа
     lb3 v3.asm:
     ; Шаблон текста программы на ассемблере для модуля типа .СОМ
     TESTPC SEGMENT
        ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
        ORG 100H
     START: JMP BEGIN
     ; ДАННЫЕ
     MEM SIZE db 'MEM SIZE:
                                           ',ODH,OAH,'$'
     EXTEND MEM SIZE db 'EXTEND MEM SIZE:
                                                        ',0DH,0AH,'$'
     MCU db 'Memory control unit: adress-
                                              ; type of part-
size of part- ; SC or SD-
                                            ', ODH, OAH, '$'
     WORNING db ODH, OAH, '
                                                 !!! WORNING !!! !!!
WORNING !!! !!! WORNING !!!', ODH, OAH, ODH, OAH, '$'
     ;ПРОЦЕДУРЫ
     ;-----
```

```
TETR TO HEX PROC near
   and AL, OFh
   cmp AL,09
   jbe NEXT
   add AL,07
NEXT: add AL, 30h
   ret
TETR TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO HEX PROC near
; байт в АL переводится в два символа шестн. числа в АХ
   push CX
   mov AH, AL
   call TETR TO HEX
   xchg AL, AH
   mov CL,4
   shr AL, CL
   call TETR TO HEX ;в AL старшая цифра
   рор СХ ;в АН младшая
   ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD TO HEX PROC near
;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
   push BX
   mov BH, AH
   call BYTE TO HEX
   mov [DI], AH
   dec DI
   mov [DI], AL
   dec DI
   mov AL, BH
   call BYTE TO HEX
   mov [DI], AH
   dec DI
   mov [DI], AL
    pop BX
    ret
WRD TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
   push CX
   push DX
   xor AH, AH
   xor DX, DX
   mov CX, 10
loop bd: div CX
   or DL, 30h
   mov [SI], DL
   dec SI
   xor DX, DX
   cmp AX, 10
   jae loop bd
   cmp AL,00h
```

```
je end l
   or AL,30h
   mov [SI], AL
end_l: pop DX
   pop CX
   ret
BYTE TO DEC ENDP
;-----
WRD TO DEC PROC near
; ax - paragraph, si - low digit of result
   push bx
   push dx
   mov bx, 16
   mul bx
   mov bx, 10
   convert:
       div bx
       add dl, '0'
       mov [si], dl
       dec si
       xor dx, dx
       cmp ax, 0000h
       jne convert
   pop dx
   pop bx
   ret
WRD_TO_DEC ENDP
print_st PROC near
   mov AH, 09h
   int 21h
   ret
print st ENDP
print symb PROC near
   push ax
   mov ah, 02h
   int 21h
   pop ax
   ret
print symb ENDP
PRINT_MEM_SIZE PROC near
   push ax
   push dx
   push cx
   push bx
   push si
   MOV AH, 4AH
   MOV BX, OFFFFH ; заведомо большая память
   INT 21H
   mov si, offset MEM SIZE
   add si, 18
   mov ax, bx
```

```
call WRD TO DEC
    mov dx, offset MEM SIZE
    call print st
   pop si
    pop bx
    рор сх
    pop dx
   pop ax
   ret
PRINT MEM SIZE ENDP
PRINT EXTEND MEM SIZE PROC near
    push ax
   push dx
   push cx
   push bx
    push si
    mov AL, 30h; запись адреса ячейки CMOS
    out 70h, AL
    in AL,71h ; чтение младшего байта
    mov BL, AL
    mov AL, 31h ; запись адреса ячейки CMOS
    out 70h, AL
    in AL,71h
   mov BH, AL
    mov si, offset EXTEND MEM SIZE
    add si, 25
    mov ax, bx
    call WRD TO DEC
    mov dx, offset EXTEND MEM SIZE
    call print st
    pop si
    pop bx
    рор сх
   pop dx
   pop ax
    ret
PRINT EXTEND MEM SIZE ENDP
PRINT MCU PROC near
    push ax
    push dx
   push cx
   push bx
   push si
   mov di, offset MCU
    add di, 33
    mov ax, es
    call WRD TO HEX
   mov di, offset MCU
    add di, 54
```

```
mov ax, es:[01h]
    call WRD TO HEX
   mov si, offset MCU
    add si, 77
    mov ax, es:[03h]
    call WRD TO DEC
    mov di, offset MCU
    add di, 91
    mov si, 8
sc_sd:
   mov bx, es:[si]
    mov [di], bx
    add si, 2
     add di, 2
    cmp si, 16
     jb sc sd
   mov dx, offset MCU
   call print st
   pop si
   pop bx
   pop cx
   pop dx
   pop ax
   ret
PRINT MCU ENDP
PRINT CHAIN MCU PROC near
   push ax
   push dx
   push cx
   push bx
   push si
   push es
   mov ah, 52h
    int 21h
   mov es, es: [bx-2]
chain:
   call PRINT MCU
   mov ah, es:[0]
   cmp ah, 5Ah
   je end_
   mov ax, es
    add ax, es:[3]
    inc ax
   mov es, ax
    jmp chain
end :
   pop es
   pop si
   pop bx
   рор сх
   pop dx
```

```
pop ax
   ret
PRINT CHAIN MCU ENDP
CLEAN MEM PROC near
   push ax
    push bx
    push dx
    mov ax, offset FINAL_LB3
   mov bx, 10h
    xor dx, dx
    div bx
   inc ax
   mov bx, ax
   mov al, 0
   mov ah, 4ah
   int 21h
   pop dx
    pop bx
   pop ax
   ret
CLEAN MEM ENDP
EXTRA MEM PROC near
    push ax
    push bx
   push dx
   mov bx, 1000h
    mov ah, 48h
    int 21h
    jnc end ask
    mov dx, offset WORNING
    call print st
end_ask:
   pop dx
   pop bx
   pop cx
   ret
EXTRA MEM ENDP
; КОД
BEGIN:
    call PRINT MEM SIZE
   call PRINT EXTEND MEM SIZE
    call EXTRA MEM
   call CLEAN MEM
   call PRINT CHAIN MCU
; Выход в DOS
   xor AL, AL
   mov AH, 4Ch
   int 21H
FINAL LB3:
TESTPC ENDS
    END START ; конец модуля, START - точка входа
```